

金属硅成分检测 硅微粉，碳化硅品位化验

产品名称	金属硅成分检测 硅微粉，碳化硅品位化验
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

金属硅成分检测 硅微粉，碳化硅品位化验

概述
目前，国际通用作法是把商品硅分成金属硅和半导体硅。金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右（近年来，含Si量99.99%的也归在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。半导体硅用于制作半导体器件的高纯度金属硅。是以多晶、单晶形态出售，前者价廉，后者价昂。
检验范围
晶体硅，石英玻璃管材、石英加热管产品，石英电光源产品，石英器件、石英砂和硅微粉，碳化硅，金属硅，熔融石英，水晶工艺品等10大类45项产品的检验。
检测能力
Al、Fe等元素分析，P、B元素分析，Fe元素分析，单晶硅中B、P，霍尔系数，迁移率，电阻率，粒度分析，形态分析，羟基含量，水分测定，二氧化硅含量，碳化硅含量等。
相关检测标准
GB/T 14849 工业硅化学分析方法
GB/T 2881 工业硅
GB/T 24581 低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中III、V族杂质含量的测试方法
GB/T 6616 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定非接触涡流法

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

SEMI MF1630 单晶硅 - 级杂质的低温FT - IR分析测试方法

GB/T 1553 硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

SEMI MF 1535-1106 非接触微波反射光电导衰减测试硅晶片载流子复合寿命的方法

GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 4061 硅硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 11073 多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 12964 硅单晶抛光片

GB/T 13387 电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 6620 硅片弯曲度非接触式测试方法

YS/T26 硅片边缘轮廓检验方法

GB/T 14142 硅外延层晶体完整性检验方法腐蚀法

GB/T5252 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法

GB/T 24582 酸浸取原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污染物

YS/T 24 外延钉缺陷的检验方法等。